20a-A12-10

PARE 法により作製した Mg_xZn_{1-x}0:N/Zn0 ヘテロ接合の EL 特性

EL characteristics of Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO heterojunction fabricated by the PARE method

岩手大¹、仙台高専²

〇中川玲¹、阿部貴美¹、千葉鉄也¹、中川美智子¹、高橋修三¹、千葉茂樹¹、柏葉安宏²、 小島勉¹、新倉郁生¹、柏葉安兵衛¹、長田洋¹

Iwate Univ.¹, Sendai Nat. College of Tech.²

OA. Nakagawa¹, T. Abe¹, T. Chiba¹, M. Nakagawa¹, S. Takahashi¹, S. Chiba¹, Y. Kashiwaba²,

T. Ojima¹, I. Niikura¹, Y. Kashiwaba¹, H. Osada¹,

E-mail: akirana@iwate-u.ac.jp

【はじめに】

我々は、これまで蒸着原料に ZnMg 合金を用い たプラズマアシスト反応性蒸着 (PARE) 法によ って単結晶 ZnO 基板上への Mg_xZn_{1-x}O 薄膜および Mg_xZn_{1-x}O:N 薄膜の作製を試み、その結果と諸特 性について報告してきた [1-5]。

今回は、PARE 法によって作製した Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO ヘテロ接合のEL 発光特性につ いて報告する。

【実験方法】

ZnMg合金(Mg=30~35 wt%)を入れたルツボを 加熱し、蒸気を O_2 、 N_2 、NOの混合ガスの高周波 プラズマ中を通して ZnO (0001)単結晶基板上に 到達させ、 $Mg_xZn_{1-x}O$:N 膜を作製した。基板温度 は 600~850°C、ルツボ温度は 600~700°C、プラ ズマ高周波電力は 200 W とした。素子は $Mg_xZn_{1-x}O$:N 上に Au/Ni 電極、ZnO 基板上に AI 電極をそれぞれ作製し、Au/Ni 電極を+極、AI 電 極を-極として EL 発光の観察を行った。

【実験結果および考察】

Fig.1 には ZnO 単結晶基板上に作製した Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO ヘテロ接合の XRD 測定結果を 示した。72.6 deg.と 72.7 deg.に ZnO (0004)と Mg_xZn_{1-x}O (0004)の回折ピークが観察された。 Mg_xZn_{1-x}O 薄膜の回折ピークは混晶であるため ZnO 単結晶基板の回折ピークに比べ、ブロードで あるが、フリンジが明瞭なことから急峻な界面お よび平坦な薄膜が作成できていることが分かり、 良好なヘテロ接合が形成できていると考えられ る。また、ドープした N 濃度は SIMS 測定から 2×10^{19} cm⁻³程度であることが分かった。 Fig.2 には Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO ヘテロ接合を用い て作製した素子の EL 発光スペクトルを示した。 380 nm に ZnO の励起子発光起因のピークが観察 されており、ZnO 基板側での再結合による発光と 考えられる。



Fig. 1 Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO ヘテロ接合の XRD 測定結果



Fig. 2 Mg_xZn_{1-x}O:N/ZnO ヘテロ接合の EL スペクトル

【謝辞】本研究は JST 復興促進プログラム(マッチング促進)の支援を受けたものであり、ここに感謝する。

- [1] 阿部ほか、2011 年春季第58 回応用物理学会学術講演会予稿集、26a-KL-13.
- [2] T.Abe, et al., Phys. Status Solidi C 9, No.8-9, 1813-1816 (2012).
- [3] 阿部ほか、2011 年秋季第72 回応用物理学会学術講演会予稿集、1a-N-14.
- [4] 中川ほか、2012 年秋季第73 回応用物理学会学術講演会予稿集、13p-H7-14.
- [5] 中川ほか、2013 年秋季第74 回応用物理学会学術講演会予稿集、17a-B4-11.